

наблюдения $\tau \gg (\delta_e^{-1}, \omega_\mu^{-1}, \delta_\mu^{-1})$ из (3) для естественной неустойчивости частоты получаем

$$\sigma_\tau \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_0} \right) = \left[\left(\frac{\hbar \omega_0}{2} \operatorname{cth} \frac{\hbar \omega_0}{2\kappa T} + \kappa T_N \right) \times \right. \\ \times (2Q_e^2 W)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{64 W^2 Q_e^2}{5 E_{Ю}^2 V \omega_\mu^4 \tau^4 \rho^2} \right) + \\ \left. + \frac{8\kappa T_\mu \delta_\mu}{E_{Ю} V \omega_\mu^2} + \frac{4\kappa T^2 \alpha_\tau^2 \tau_\tau}{C_V V} \right]^{1/2} \tau^{-1/2}. \quad (4)$$

Здесь для простоты положено $\rho > \alpha_1 \lambda$. Из соотношения (4) следует, что имеется не зависящее от мощности W предельное значение для $\sigma_\tau(\Delta\omega/\omega_0)$, которое достигается при $W = W_{\text{огр}} = \frac{\sqrt{5} E_{Ю} V \omega_\mu^2 \rho}{8 Q_e \pi^2} \tau^2$.

В частности, для $T_\mu \rightarrow 0$ и $\tau_\tau \rightarrow 0$ этот предел имеет вид

$$\sigma_\tau \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_0} \right) = \left(\frac{(\hbar \omega_0 / 2 \cdot \operatorname{cth}(\hbar \omega_0 / (2\kappa T)) + \kappa T_N) \cdot 8 \pi^2}{\sqrt{5} E_{Ю} V Q_e \omega_\mu^2 \rho \tau^3} \right)^{1/2}. \quad (5)$$

При $\hbar \omega_0 / \kappa \gg (T_N, T)$ формула (5) стремится к своему квантовому пределу [2]:

$$\sigma_\tau \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_0} \right)_{\text{мин}} = \left(\frac{8 \pi^2 \hbar \delta_e}{\sqrt{5} E_{Ю} V \omega_\mu^2 \rho \tau^3} \right)^{1/2}. \quad (6)$$

Сравнивая (5), (6) с предельным значением неустойчивости частоты для изохронных генераторов [2, 3], видим, что влияние амплитудных флуктуаций в неизохронных генераторах уменьшается в $(\omega_\mu \tau)^2$ раз и основной вклад в естественные вариации частоты могут давать механические и термодинамические флуктуации резонансной системы генератора.

В заключение автор благодарит В. В. Брагинского и В. И. Панова за внимание и ценные дискуссии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Брагинский В. Б., Вятчанин С. П. ЖЭТФ, 1978, 74, с. 828.
[2] Брагинский В. Б., Вятчанин С. П., Панов В. И. ДАН СССР, 1979, 247, № 3, с. 583. [3] Панов В. И., Руденко В. Н. Радиотехн. и электроника, 1979, 24, № 3, с. 1036. [4] Малахов А. Н. Флуктуации в автоколебательных системах. М.: Наука, 1968.

Поступила в редакцию
10.03.83

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1983, Т. 24, № 6

УДК 537.311.21

О ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРОВОДИМОСТИ ДВУМЕРНЫХ СИСТЕМ В РЕЖИМЕ СЛАБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

П. А. Воробьев, И. П. Звягин

(кафедра физики полупроводников)

В ряде теоретических и экспериментальных работ было показано, что при низких температурах T в проводимости двумерных систем имеется логарифмически зависящая от T часть. Появление логарифмиче-

ской температурной зависимости связано с диффузионным характером движения электронов при упругом рассеянии на примеси.

«Локализационные поправки» к проводимости при постоянном токе σ_L обусловлены веерными диаграммами, сумма которых имеет полюсную структуру [1, 2]. Логарифмическая расходимость выражения для σ_L при малых значениях суммарного импульса в случае рассеяния назад устраняется путем учета неупругих процессов. Для рассеяния на короткодействующих потенциалах и круговой поверхности Ферми расчет дает [1, 2]

$$\sigma_L = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} \ln \frac{\tau_{in}}{\tau}, \quad (1)$$

где τ и τ_{in} — времена релаксации для упругих и неупругих процессов соответственно. Часто можно положить $\tau_{in} \sim T^{-p}$. При этом выражение (1) логарифмически зависит от температуры.

Диффузионные полюсы в выражениях для проводимости при учете взаимодействия между электронами дают «корреляционную» поправку к проводимости, которая в низшем порядке по взаимодействию имеет вид [3, 4]

$$\sigma_I = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} g \ln \frac{\hbar}{T\tau}. \quad (2)$$

Здесь g — безразмерная константа электрон-электронного взаимодействия. Логарифмическая зависимость σ_I от T связана с тем, что взаимодействие носителей идет с передачей энергии, и при конечных температурах тепловое размытие фермиевского распределения приводит к появлению эффективного затухания, пропорционального T . Наряду с этим неупругие процессы, приводящие к затуханию одноэлектронных состояний с данной энергией, также могут приводить к эффективному обрезанию логарифмических расходимостей. Учет затухания, связанного с неупругими процессами, приводит к тому, что под знаком логарифма в (2) фактически стоит величина $\max(\hbar/(T\tau), \tau_{in}/\tau)$.

Техника вычислений аналогична использованной в работе [5]. При учете неупругого затухания диффузионные полюсы имеют вид

$$(Dq^2 + |\omega_n| + \tau_{in}^{-1})^{-1}, \quad (3)$$

где q — суммарный импульс, D — коэффициент диффузии, а ω_n — мацубаровские частоты. Используя выражение (3), получаем для корреляционной поправки σ_I :

$$\sigma_I = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} g \left(\ln \frac{\tau_{in}}{\tau} + \Phi \left(\frac{\hbar}{T\tau} \right) \right), \quad (4)$$

где функция Φ определяется выражением

$$\Phi(\mu) = 2 \int_0^{\infty} \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{e^x - 1} \right) \frac{x dx}{x^2 + \mu^2} = \begin{cases} \ln \mu, & \mu \ll 1, \\ -\pi^2/3\mu^2, & \mu \gg 1. \end{cases}$$

При $\hbar/\tau_{in} \ll T$ отсюда получается формула (2), а при $\hbar/\tau_{in} \gg T$ функцией Φ можно пренебречь, так что $\sigma_I \sim \ln T$.

Аналогично для корреляционного вклада в магнитосопротивление при одновременном учете температурного и неупругого затуханий находим:

$$\Delta\sigma_I = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} \{ g [f(x) + J(\alpha/x, \alpha) - \Phi(\hbar/T\tau_{in})] - \beta f(x) \}. \quad (5)$$

Здесь

$$f(x) = \ln(1/x) - \Phi(1/2 + 1/x),$$
$$J(x, \alpha) = \alpha \int_0^{\infty} \frac{\exp(-2\alpha t)}{\operatorname{sh} \alpha t} \left(\frac{t^2}{\operatorname{sh}^2 t} - 1 \right) dt,$$

$$x = 4DeH\tau/\hbar c, \quad \alpha = 2DeH/\pi Tc,$$

$\beta(g)$ — функция, табулированная в [6], а последнее слагаемое в (5) есть вклад поправок Маки — Томпсона.

Если неупругое затухание мало ($\hbar/T_{in} \ll T$), то из формулы (5) получается результат работы [7]:

$$\Delta \sigma_I = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} g \varphi(\alpha),$$
$$\varphi(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{t}{\operatorname{sh} \alpha t} \left(\frac{\alpha t}{\operatorname{sh} \alpha t} - 1 \right) dt. \quad (6)$$

В обратном предельном случае функции J и Φ в (5) малы, так что

$$\Delta \sigma_I = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} (g - \beta) f(x).$$

В области магнитных полей $eDH/c \gg \hbar/\tau_{in} \gg T$ из (6) получаем

$$\Delta \sigma_I = - \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar} (g - \beta) \ln \frac{\hbar c}{DeH\tau_{in}}. \quad (7)$$

Таким образом, корреляционный вклад в проводимость двумерных неупорядоченных систем может быть пропорционален как $\ln T$, так и $p \ln T$ в зависимости от того, что доминирует: температурное уширение или неупругое затухание. Вероятно, это обстоятельство может быть существенно при экспериментальном разделении локализационных и корреляционных вкладов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Abrahams E. et al. Phys. Rev. Lett., 1979, 42, p. 673. [2] Горьков Л. П., Ларкин А. И., Хмельницкий Д. Е. Письма в ЖЭТФ, 1979, 30, с. 248. [3] Altshuler B. L., Aronov A. G., Lee P. A. Phys. Rev. Lett., 1980, 44, p. 1288. [4] Фукуяма Н. J. Phys. Soc. Jap., 1980, 48, p. 2169. [5] Альтшулер Б. Л., Аронов А. Г. ЖЭТФ, 1979, 77, с. 2028. [6] Ларкин А. И. Письма в ЖЭТФ, 1980, 31, с. 239. [7] Альтшулер Б. Л. и др. ЖЭТФ, 1981, 81, с. 768.

Поступила в редакцию
22.03.83

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1983. Т. 24, № 6

УДК 621.315.592

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ УДАРНОЙ ИОНИЗАЦИИ В СПЛАВЕ

$\text{Hg}_{0,80}\text{Cd}_{0,20}\text{Te}$

Е. В. Богданов, Н. Б. Брандт, Л. С. Флейшман

(кафедра физики низких температур)

Несмотря на то что исследованию влияния сильного электрического поля на носители заряда в полупроводниковых сплавах $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ посвящено значительное число работ (см., например,